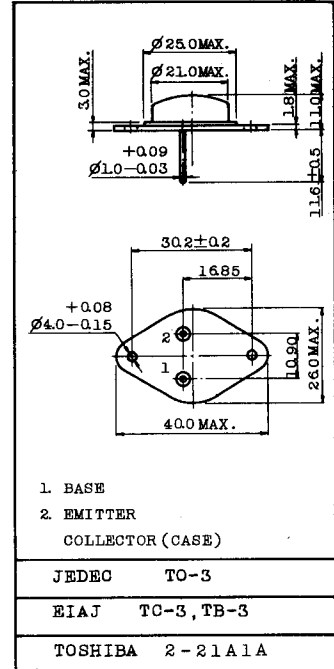


シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

2SD424

- 電力増幅用
- Power Amplifier Applications
- ・ コレクタ損失が大きい。 : $P_C = 150W$
- ・ 高耐圧です。 : $V_{CBO} = 180V$
- ・ 2SB554とコンプリメンタリになります。
- ・ 100W Hi-Fi オーディオアンプ出力段に最適です。
- ・ Complementary to 2SB554
- ・ Recommended for 100 W High-Fidelity Audio Frequency Amplifier Output Stage.

Unit in mm



最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	180	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	180	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	15	A
エミッタ電流	I_E	-15	A
コレクタ損失	P_C	150	W
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~150	$^\circ C$

アクセサリは AC 73 を適用
MOUNTING KIT NO. AC 73

2SD424

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25 °C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	I_{CB0}	$V_{CB}=90V, I_E=0$	—	—	100	μA
エミッタシャ断電流	I_{EB0}	$V_{EB}=5V, I_C=0$	—	—	100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=0.1A, I_B=0$	180	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_E=10mA, I_C=0$	5	—	—	V
直流電流増幅率 (Note)	h_{FE}	$V_{CE}=5V, I_C=2A$	40	—	140	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10A, I_B=1A$	—	—	3.0	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CC}=5V, I_C=10A$	—	—	2.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=5V, I_E=2A$	—	5	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0$ $f = 1MHz$	—	300	—	pF

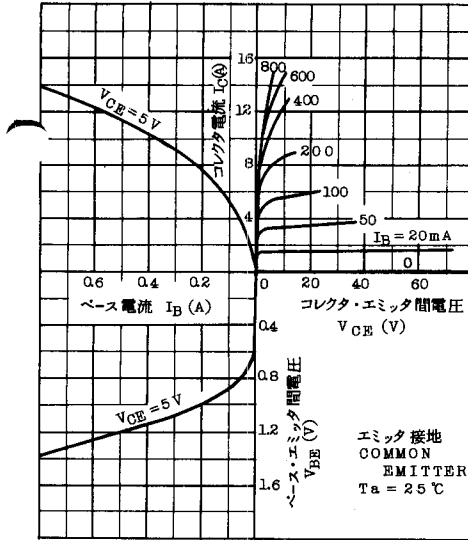
Note ; h_{FE} により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of h_{FE} , the 2SD424 is classified as follows.

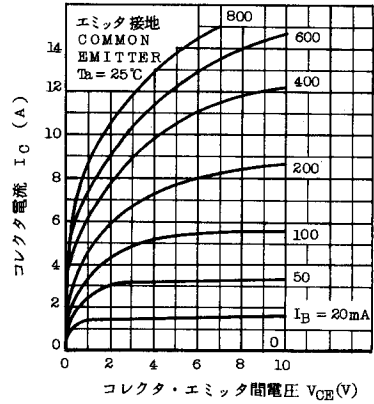
CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SD424-R	40	80
2SD424-O	70	140

2SD424

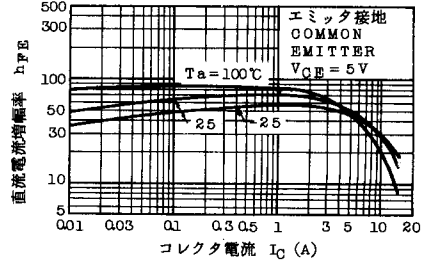
STATIC CHARACTERISTICS



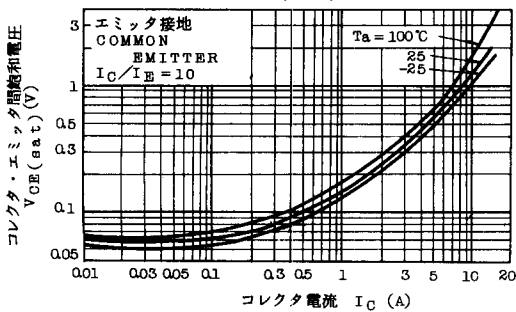
$I_C - V_{CE}$ (LOW VOLTAGE REGION)



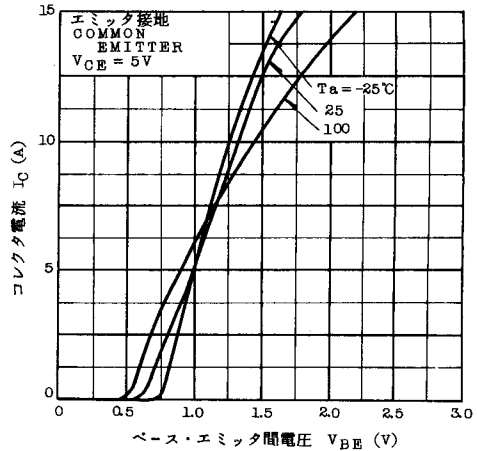
$h_{FE} - I_C$



$V_{CE(sat)} - I_C$

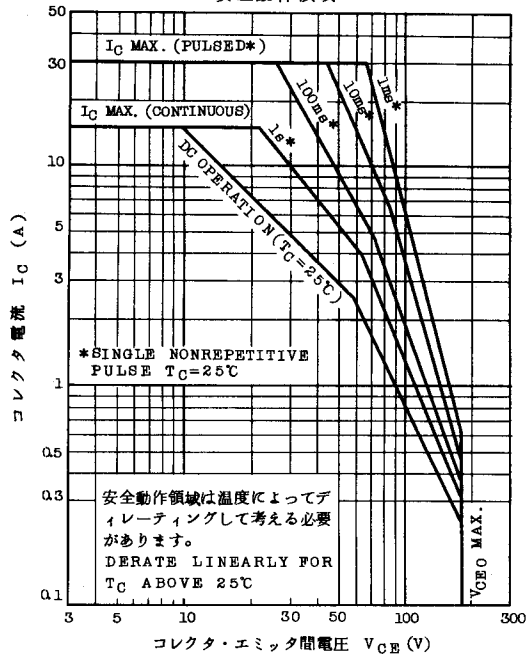


$I_C - V_{BE}$

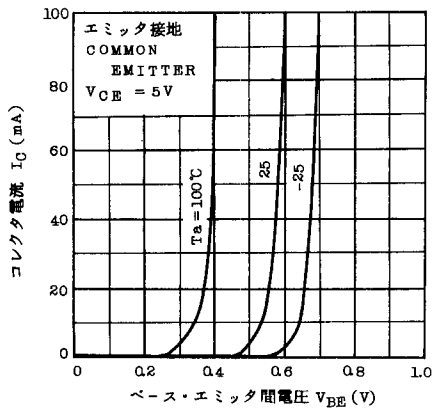


2SD424

安全動作領域 ASO



$I_C - V_{BE}$ (LOW CURRENT REGION)



$P_C - T_C$

